

产品概览

NTMFD4C20N: 双 N 沟道，功率 MOSFET，30V

欲看完整文档，请参阅数据表。

双 N 沟道，功率 MOSFET，30 V，高压侧 18 A / 低压侧 27 A，双 N 沟道，SO8FL

特性

- Co-Packaged Power Stage Solution to Minimize Board Space
- Minimized Parasitic Inductances
- Optimized Devices to Reduce Power Losses
- RoHS Compliant

应用

- DC-DC Converters
- System Voltage Rails
- Point of Load

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS}^{(BR)}$ Min (V)	V_{GS}^{Max} (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	I_D^{Max} (A)	P_D^{Max} (W)	$R_{DS(on)}^{n} Max @ V_{GS} = 2.5 V (m\Omega)$	$R_{DS(on)}^{n} Max @ V_{GS} = 4.5 V (m\Omega)$	$R_{DS(on)}^{n} Max @ V_{GS} = 10 V (m\Omega)$	$Q_g^{Typ} @ V_{GS} = 4.5 V (nC)$	$Q_g^{Typ} @ V_{GS} = 10 V (nC)$	$C_{iss}^{Typ} (pF)$	Package Type
NTMFD4C20NT1G	0.4667	Pb-free Halide free	Active	N-Channel	Dual	30	20	2.1	18.2	1.88	-	Q1: 10.8, Q2: 5.2	Q1: 7.3, Q2: 3.4	9.7	9.3	Q1: 970, Q2: 1950	SO-8FL Dual / DFN-8
NTMFD4C20NT3G	0.4667	Pb-free Halide free	Active	N-Channel	Dual	30	20	2.1	18.2	1.88	-	Q1: 10.8, Q2: 5.2	Q1: 7.3, Q2: 3.4	9.7	9.3	Q1: 970, Q2: 1950	SO-8FL Dual / DFN-8

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于：8/3/2020